

加熱機構を搭載、処理効果2倍 「プラズマエッチャー加熱機構付 CPE-200AHM」 2021年9月2日発売

プラズマ装置を開発販売する株式会社 魁半導体(京都府京都市下京区、代表取締役 田口貢士)は、当社初の加熱機構を搭載した真空プラズマ装置「プラズマエッチャー加熱機構付 CPE-200AHM」を開発、2021年9月2日に新発売します。基材を温めてプラズマ照射することにより、従来比で約2倍の高い処理効果を実現しました。

■当社初の加熱機構を搭載

真空プラズマ装置「プラズマエッチャー加熱機構付 CPE-200AHM」は基材を設置するステージを最高400℃まで加熱する機構を搭載し開発した製品です。プラズマ処理は基材に高いエネルギー照射をすることにより洗浄や表面改質などの処理をする技術ですが、基材を温めプラズマ処理することで、基材によっては従来約2倍の高い処理効果を得ることができます。当社への受託処理の依頼が増加していることから市場調査を行い、新開発に至りました。

ステージサイズφ200mmを基準に新製品群「CPE-AHMシリーズ」として展開します。用途例としては半導体製造工程のレジスト除去の効率化や、Oリングなどのプラズマ耐久性評価試験での大幅な時間短縮が期待できます。

■製品概要

[名称] プラズマエッチャー加熱機構付 CPE-200AHM
(右写真：外観)

[発売日] 2021年9月2日

[特徴] ・プラズマ処理時間を大幅に短縮
・カスタム対応

[用途] エッチング、プラズマ耐久性テスト

[価格] ステージサイズφ200：1,600万円(税別)

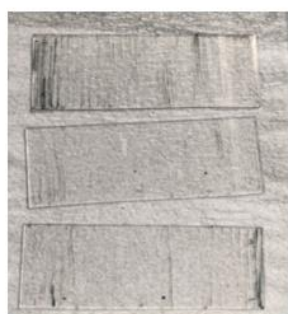


(※ 1) 当社比較実験：アッシング実験結果

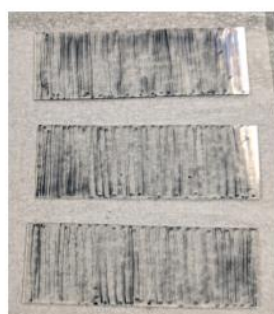
スライドガラス表面を油性ペンで塗ったものを基材として実験。新製品「CPE-200AHM」を使用し予めステージを 300℃に加熱した場合と加熱しない場合、それぞれプラズマ照射し塗膜をアッシング除去し一定時間毎に重量を測定。

[結果] 30 秒照射後の除去量（重量変化）は 300℃に加熱することで約 2 倍に増加。

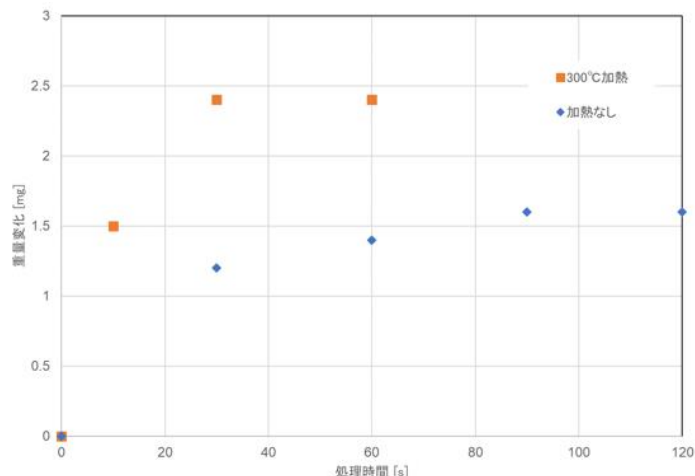
（重量変化が約 2.5mg で飽和しているのは、塗膜が除去され基材が露出した）



300℃加熱
30秒照射後



加熱なし
30秒照射後



■ 製品概要

型式	真空プラズマ装置「プラズマエッチャー加熱機構付 CPE-200AHM」
外形寸法	W560mm×D690mm×H1650mm
電極ステージ	直径 200mm
電極間距離	50mm
放電方式	高周波(13.56MHz)、平行平板方式
放電出力	0～300W
ステージ加熱	最高温度 400℃
ガス導入	2 系統
処理圧力調整	自動制御
電源	単相 200V, 30A

◆CPE-200AHM 製品紹介ページ <https://sakigakes.co.jp/products/cpe-200ahm/>

【お問合せ先】 株式会社 魁半導体 <https://sakigakes.co.jp/>

TEL : 075-204-9589 / FAX : 050-3488-5883 / E-mail : s.sales@sakigakes.co.jp

京都府京都市下京区西七条御前田町 50 番地 SAKIGAKE ビル